
	<h2>SI7619DN-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7619DN-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 24A 1212-8 PPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7619DN-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 30433 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI7619DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 24A 1212-8 PPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	30433 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 24A (Tc) 3.5W (Ta), 27.8W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 27.8W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21 mOhm @ 10.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7619DN-T1-GE3TR


SI7619DN-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7619DN-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7619DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7619DN-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SI7620DN-T1-E3</b> VISHAY VISHAY PAK1212	 <b>SI7621DN</b> VISHAY SI7621DN VISHAY	 <b>SI7621DN-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 4A 1212-8 PPAK	 <b>SI7617DN-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 35A 1212-8 PPAK
 <b>SI7617DN-T1-E3</b> Vishay Precision Group SI7617DN-T1-E3 VISHAY	 <b>SI7619DN-T1-E3</b> VISHAY VISHAY PAK1212	 <b>SI7619DN-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 24A 1212-8 PPAK	 <b>SI7620DN-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 150V 13A 1212-8

heiße Teile

Mehr

 SI7491DP	 SI7491DP-T1-GE3	 SI7491DP-T1-GE3	 SI7501DN-T1-E3	 SI7501DN-T1-E3
 SI7540ADP-T1-GE3	 SI7540ADP-T1-GE3	 SI7540DP-T1-E3	 SI7540DP-T1-E3	 SI7540DP-T1-GE3
 SI7540DP-T1-GE3	 SI7606DN-T1-E3	 SI7606DN-T1-GE3	 SI7611DN-T1-GE3	 SI7611DN-T1-GE3
 SI7613DN-T1-GE3	 SI7613DN-T1-GE3	 SI7615ADN-T1-GE3	 SI7615ADN-T1-GE3	 SI7615DN
 SI7615DN-T1-E3	 SI7615DN-T1-GE3	 SI7615DN-T1-GE3	 SI7617DN-T1-GE3	 SI7617DN-T1-GE3
 SI7619DN-T1-GE3	 SI7621DN-T1-GE3	 SI7621DN-T1-GE3	 SI7625DN-T1-GE3	 SI7625DN-T1-GE3
 SI7629DN-T1	 SI7629DN-T1-GE3	 SI7629DN-T1-GE3	 SI7633DP-T1-GE3	 SI7633DP-T1-GE3
 SI7634BDP	 SI7634BDP-T1-E3	 SI7634BDP-T1-E3	 SI7634BDP-T1-GE3	 SI7634BDP-T1-GE3
 SI7634DP-T1-E3	 SI7634DP-T1-GE3	 SI7635DP	 SI7635DP-T1-GE3	 SI7635DP-T1-GE3
 SI7636DP	 SI7636DP-T1-E3	 SI7636DP-T1-E3	 SI7636DP-T1-GE3	 SI7636DP-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

